

半 导 体 学 报

第 10 卷 第 1 期 1989 年 1 月

目 录

- Zn Se_{1-x}S_x 中 3d 过渡金属杂质施主能级·····顾一鸣 黄明竹 汪克林 (1)
- 硅表面原子芯态能级的化学位移·····邢益荣 钟学富 (8)
- In_{0.25} Ga_{0.75} As/GaAs 应变异质结的离子沟道分析 ·····
- 殷士端 吴春武 张敬平 刘家瑞 朱沛然 (12)
- SI-、n-GaAs 正电子湮没特性的研究·····
- 吴凤美 沈德勋 滕敏康 陈 岭 唐 杰 张德宏 (18)
- Pt-Si 界面的椭偏光谱响应及 PtSi 的光学性质 ·····陈土培 黄炳忠 (24)
- VLSI 中双层布线导孔数的优化算法 ·····李英梦 唐璞山 (31)
- CEXTOR——一个适合 MOS 集成电路工艺的电路提取程序 ·····
- 宋 华 唐璞山 章开和 凌燮亭 (39)
- 晶体管 PN 结缺陷形成的 G-R 噪声研究 ·····戴逸松 (47)
- 全集成式流量传感器·····黄金彪 李 斌 童勤义 周 明 (55)
- 采用离子注入方法调整和控制氢离子敏场效应管 (pH-ISFET) 阈值电压 ···
- 汪正孝 (62)

研 究 简 报

- 利用静止畴原理制作的高灵敏度新型 GaAs Hall 器件 ·····郑一阳 (67)
- 激光结晶 a-Si:H SOI 离子注入和快速退火·····顾 清 鲍希茂 (72)

研 究 快 报

- 太空生长掺 Te-GaAs 单晶的结构缺陷观测·····
- 蒋四南 范缙文 李成基 林兰英 (76)